

# SSE 216 · SSE 219



Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistoren für digitale Anwendung.

Für den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23

Wärmewiderstand  $R_{thja}$

auf Leiterplatte (Cevausit  $\geq 0,4 \text{ cm}^2$ )  $\leq 480 \text{ K/W}$

auf Keramik  $8 \times 10 \times 0,7 \text{ mm}$   $\leq 420 \text{ K/W}$

## Grenzwerte

$U_{CBO}$	20 V
$U_{CEO}$	15 V
$U_{EBO}$	5 V
$I_C$	100 mA
$I_{CM}$	200 mA
$I_B$	20 mA
$P_{tot}$ (bei $\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$ )	300 mW
$\vartheta_j$	150 °C
$\vartheta_a$	-55 ... +125 °C

Statische Kennwerte (bei  $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$ )

$I_{CBO}$ (bei $U_{CB} = 20 \text{ V}$ )	$\leq 100 \text{ nA}$
$U_{(BR)CEO^1}$ (bei $I_C = 10 \text{ mA}$ )	$\geq 15 \text{ V}$
$h_{21E}$ (bei $I_C = 30 \text{ mA}$ , $U_{CE} = 0,5 \text{ V}$ )	Gruppe C 56-140
	D 112-280
$U_{CE_{sat}}$ (bei $I_C = 30 \text{ mA}$ , $I_B = 3 \text{ mA}$ )	$\leq 0,45 \text{ V}$

Dynamische Kennwerte (bei  $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$ )

			SSE 219
Einschaltzeit	$t_{on}$	( $I_C = 10 \text{ mA}$ , $I_{B1} = 3 \text{ mA}$ ,	$\leq 35 \text{ ns}$
Ausschaltzeit	$t_{off}$	$I_{B2} = 1,5 \text{ mA}$ , $R_L = 220 \Omega$ )	$\leq 30 \text{ ns}$

1) Messung erfolgt impulsmäßig